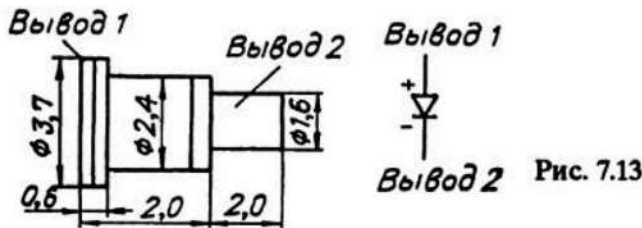


**3A726A, 3A726B, 3A726B, 3A726Г, 3A726Д,
3A726E, 3A726Ж, 3A726И**

Диоды арсенидогаллиевые, мезазпитаксиальные, на эффекте Ганна, генераторные. Предназначены для применения в генераторах сантиметрового диапазона длин волн. Выпускаются в металлокерамическом корпусе типа КД-109 с жесткими выводами. Габаритный чертеж соответствует прибору 2A706 (рис.7.13). Тип диода приводится на групповой таре. Масса диода не более 0,15 г. Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской документации: диод СВЧ 3A726A, аАО.339.133 ТУ; диод СВЧ АА726A, аАО.336.345 ТУ.



Электрические параметры

Минимальная непрерывная мощность в рабочем диапазоне частот	
3A726A, 3A726B, 3A726B, 3A726Ж, АА726A, АА726Б, АА726В, АА726Ж	100...150*...200* мВт
3A726Г, 3A726Д, 3A726E, 3A726И, АА726Г, АА726Д, АА726E, АА726И	200...250*...300* мВт
Непрерывная выходная мощность на одной из частот рабочего диапазона	
3A726A, 3A726B, 3A726B, 3A726Ж, АА726A, АА726Б, АА726В, АА726Ж	200*...250*...300* мВт
3A726Г, 3A726Д, 3A726E, 3A726И, АА726Г, АА726Д, АА726E, АА726И	300*...400*...500* мВт
Рабочий диапазон частот	
3A726A, 3A726Г, АА726A, АА726Г	12,05...13,50 ГГц
3A726Б, 3A726Д, АА726Б, АА726Д	13,50...15,00 ГГц
3A726В, 3A726E, АА726В, АА726E	15,00...16,70 ГГц
3A726Ж, 3A726И, АА726Ж, АА726И	16,70...18,00 ГГц
Постоянное рабочее напряжение	
3A726A-E, АА726A-E	5,0...8,0 В
3A726Ж, И, АА726 Ж, И	4,0...8,0 В
Постоянный рабочий ток	
	0,8*...1,4*...2,0 А
Сопротивление диода (I = 10 мА)	
при T = +25°C	0,3...0,8*...2,5 Ом
T = +70°C	0,4...3,0 Ом
T = -60°C	0,2...2,4 Ом
Емкость корпуса	
	не более 0,45 пФ
Индуктивность диода	
	не более 0,25 нГн

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение	8,5 В
Рассеиваемая мощность при T = +25°C	17,0*Вт
T = +70°C	15,0*Вт
T = -60°C	20,0*Вт
Значение допустимого статического потенциала	1000 В
Температура корпуса	+85°C
Температура окружающей среды	-60 ... +70°C
Минимальная наработка при T = +50°C	15000 ч
Срок сохраняемости	25 лет

Примечание: Допускается применение диодов при $U_p = (8,5 \pm 0,2)$ В при $T = 100^\circ\text{C}$. При этом минимальная наработка в зависимости от режима эксплуатации определяется по рис.7.33.

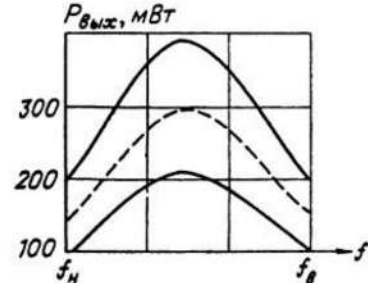


Рис.7.32. Зона возможных положений зависимости выходной мощности от частоты

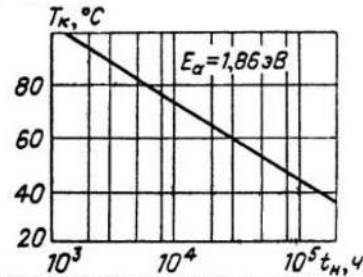


Рис.7.33. Зависимость минимальной наработки от температуры корпуса диода

Изготовитель: Томский завод при НИИ полупроводниковых приборов.